

# Information



SSE 200, SSE 201, SSE 202

2/87 (11)

Hersteller: VEB Mikroelektronik „Anna Seghers“ Neuhaus

Silizium-npn-Epitaxial-Planar-NF-Transistoren

Silizium-npn-Epitaxial-Planar-NF-Transistoren für allgemeine Anwendungen in der Hybrid- und Aufsetztechnik

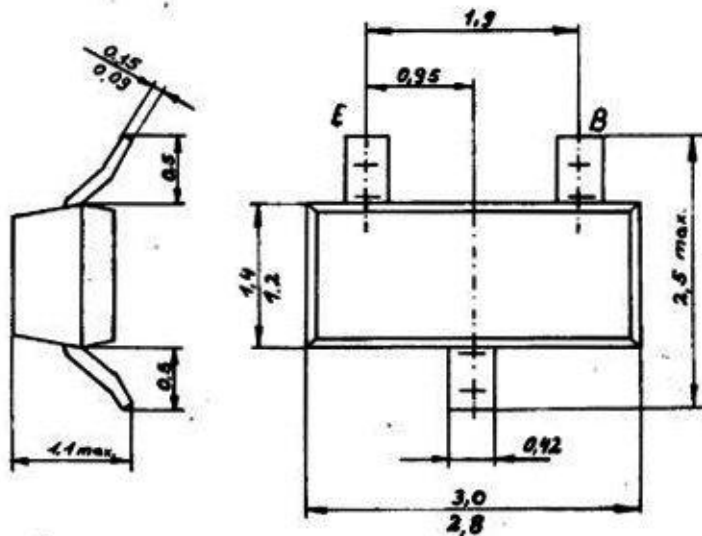


Bild 1: Gehäuse

Grenzwerte

	Kurzzeichen	SSE 200	SSE 201	SSE 202	Einheit
Kollektor-Basis-Spannung	$U_{CBO}$	70	100	120	V
Kollektor-Emitter-Spannung $-U_{BE} = 1 \text{ V}$	$U_{CEV}$	70	100	120	V
Emitter-Basis-Spannung	$U_{EBO}$	5	5	5	V
Kollektorstrom	$I_C$	30	30	30	mA
Basisstrom	$I_B$	10	10	10	mA
Gesamtverlustleistung $\theta_{amb} = 85 \text{ }^\circ\text{C}$ , $R_{thja} = 0,42 \text{ K/mW}$	$P_{tot}$	150	150	150	mW
Sperrschichttemperatur		150	150	150	$^\circ\text{C}$
Umgebungstemperaturbereich	$\theta_{amb}$	-55 ... +150	-55 ... +150	-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
Lagerungstemperaturbereich	$\theta_{stg}$	-55 ... +150	-55 ... +150	-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
Wärmewiderstand	$R_{thja}$	$\leq 0,42$	$\leq 0,42$	$\leq 0,42$	K/mW
Sperrschicht-Umgebung auf Keramik $8 \times 30 \times 0,7 \text{ mm}^3$					

Statische Kennwerte

	Kurzzeichen	SSE 200	SSE 201	SSE 202	Einheit
Kollektor-Emitter-Reststrom $-U_{BE} = 1 \text{ V}$ , $U_{CE} = U_{CEV}$	$I_{CEV}$	$\leq 1$	$\leq 1$	$\leq 1$	$\mu\text{A}$
Emitter-Basis-Reststrom $U_{EB} = 5 \text{ V}$ , $I_C = 0$	$I_{EBO}$	$\leq 100$	$\leq 100$	$\leq 100$	nA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung $I_C = 1 \text{ mA}$ , $-U_{BE} = 1 \text{ V}$	$U_{(BR)CEV}$	$\geq 70$	$\geq 100$	$\geq 120$	V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 15 \text{ mA}$ , $I_B = 0,5 \text{ mA}$	$U_{CEsat}$	$\leq 0,6$	$\leq 0,6$	$\leq 0,6$	V
Gleichstromverstärkung $U_{CE} = 3 \text{ V}$ , $I_C = 10 \text{ mA}$	$h_{21E}$	$\geq 32$	$\geq 32$	$\geq 32$	

Die vorliegenden Datenblätter dienen ausschließlich der Information! Es können daraus keine Liefermöglichkeiten oder Produktionsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.

# RFT

Herausgeber

vab applikationszentrum elektronik berlin  
im vab kombinat mikroelektronik

Mainzer Straße 25, PF 211

Berlin 1035

Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981; 011 3055